

Fotodiodă selectivă cu sensibilitate modulată pe baza heterostructurilor compușilor III–V ce conține un substrat cu bandă energetică interzisă  $E_{g0}$ , pe care sunt depuși consecutiv un strat activ intrinsec cu  $E_{g1}$ , un strat frontal cu  $E_{g2}$ , grosimea căruia este mai mare decât lungimea de difuzie a purtătorilor de sarcină minoritari și în care la heterogranita cu stratul activ este formată prima joncțiune p-n, și un strat antireflectan cu  $E_{g3}$ , totodată  $E_{g1} < E_{g2} < E_{g0} < E_{g3}$ , caracterizată prin aceea că pe verso substratului sunt depuși al doilea strat activ intrinsec cu  $E_{g4}$ , grosimea căruia este mai mică ca lungimea de difuzie a purtătorilor de sarcină minoritari și un strat cu  $E_{g1}$  în care la heterogranita cu al doilea strat activ este formată a doua joncțiune p-n, totodată  $E_{g4} < E_{g1} < E_{g2} < E_{g0} < E_{g3}$ .